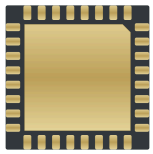
10–1100 MHz GaN 封装功率放大器 — PSAT ≥ 40 dBm

LCI-PA-10-1100-PS40MIN · 10–1100 MHz · GaN 封装功率放大器.

RF 电气表参数: PSAT ≥ 40 dBm; 功率增益 ≥ 13 dB; PAE ≥ 60 %. RF 测试条件: TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW.



QFN32 5 × 5 mm

先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。

Vg: C = 10 µF

T_peak ≤ 260 °C

RFin / Vg: 4, 5

RFout / Vd: 20, 21

GND: 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32

封装外形尺寸: 5 × 5 × 1 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = +28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 23 dBm; CW

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频率	f	10	-	1100	MHz
饱和输出功率	-	40	-	-	dBm
功率增益	-	13	-	-	dB
功率附加效率	-	60	-	-	%
功率增益平坦度	-	-	-	±0.5	dB

直流偏置与电流

参数	符号	最小值	典型值	最大值	数值	单位
漏极电压	-	-	-	-	28	V
栅极电压	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

极限参数

极限参数，不作为正常工作设定值。

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
漏源最大正向电压	-	-	-	32	V
栅极最低偏置电压	-	-5	-	-	V
储存温度	-	-65	-	150	°C
最大输入功率	-	-	-	27	dBm

封装外形尺寸

参数	数值	单位
封装外形尺寸	5 × 5 × 1	mm

引脚定义

功能符号	序号	功能
GND	1,8,9,16,17,24,25,32	-
NIC	2,3,6,7,10,11,12,13,14,15,18,19,22,23, 26,27,28,29,30,31	内部未连接，可接地
RFin	4,5	RF输入／栅极偏置
RFout	20,21	RF输出／漏极偏置

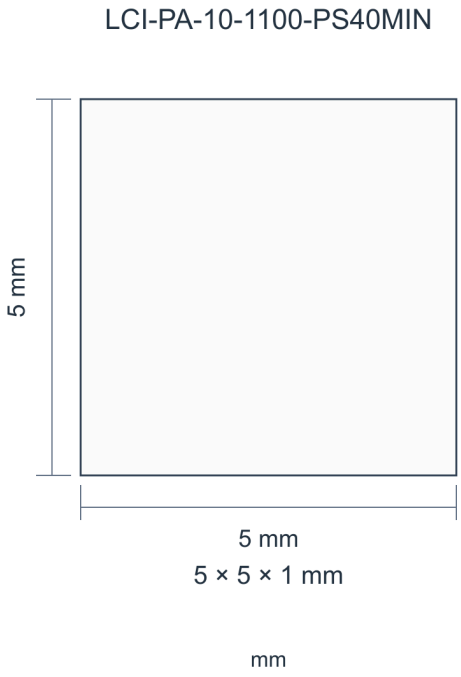
当前出版记录 · 1.6 · 2026-11-12. 产品说明或编辑内容更新。 替代版本 1.5.

集成说明

QFN32 5 × 5 mm 先加栅压，再加漏压；断电时先撤去漏压，再撤去栅压。 Vg: C = 10 µF T_peak ≤ 260 °C RFin / Vg: 4, 5 RFout / Vd: 20, 21 GND: 1, 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32 封装底部裸露焊盘必须连接RF和DC地。

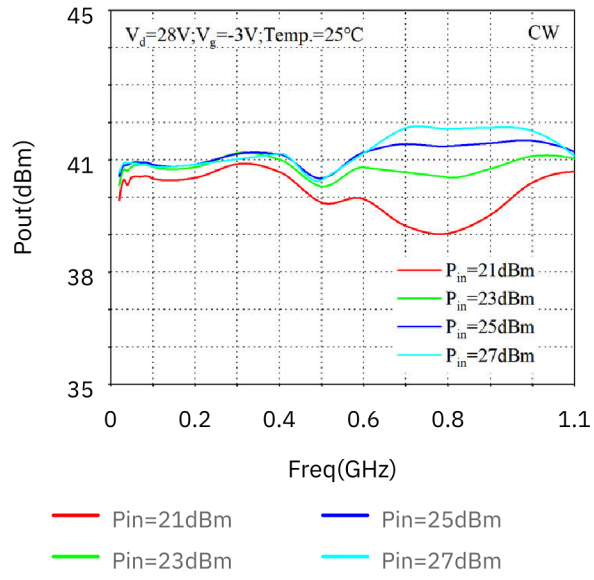
机械外形尺寸图

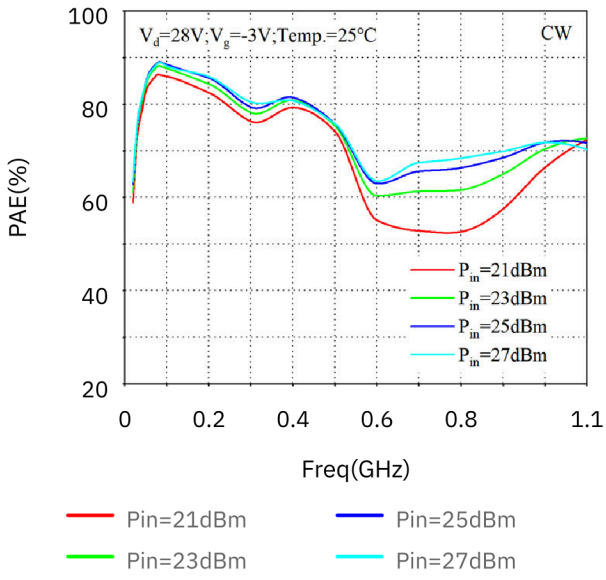
部分尺寸参考图，已确认尺寸以 mm 标注。安装时请查阅完整安装图。

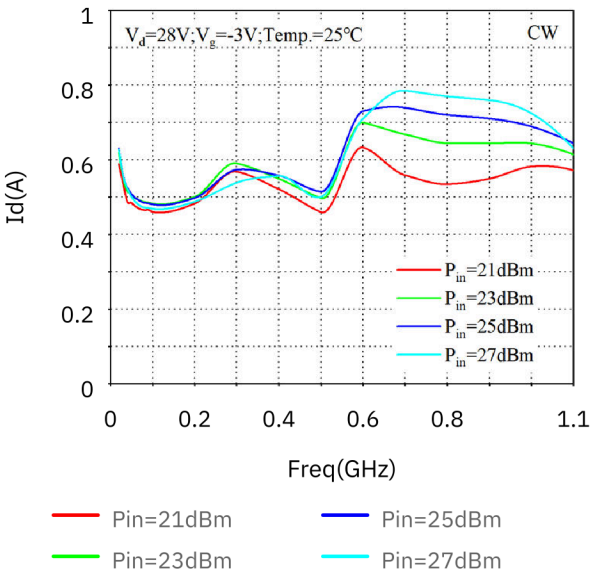


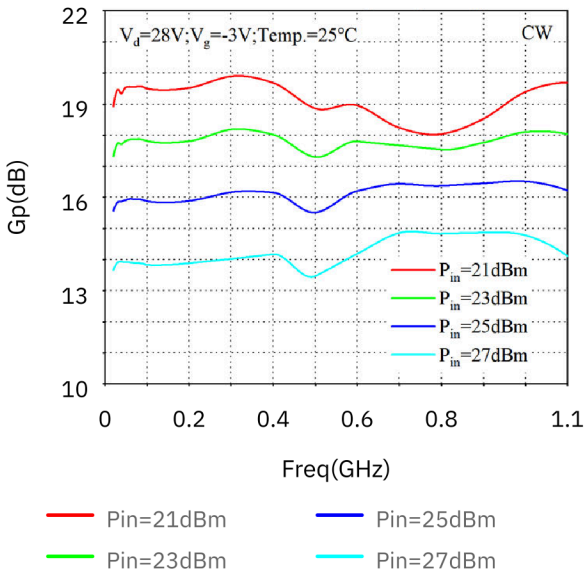
性能曲线

各性能曲线对应图中标注的工作条件。









输出功率、功率附加效率、漏极电流、功率增益。 Vd = 28 V; Vg = -3 V; TA = 25 °C; CW; Pin = 21/23/25/27 dBm.

文档说明

规格可能随产品更新而修订。设计定版前，请向 LCRF 确认当前文档版本及具体产品要求；最终供货配置以经确认的报价和订单文件为准。